

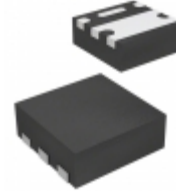



	<h2>SIA436DJ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA436DJ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA436DJ-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3099 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA436DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3099 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 8V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 15.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1508pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA436DJ-T1-GE3TR

SIA436DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA436DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA436DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA436DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIA432DJ-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA437DJ-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p><b>SIA438EDJ-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L</p>	 <p><b>SIA436DJ-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>
 <p><b>SIA438EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L</p>	 <p><b>SIA433EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA439EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 28A SC-70-6L</p>	 <p><b>SIA433EDJ</b> VISHAY SIA433EDJ VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SIA417DJ-T1-GE3	↔ SIA419DJ	⇒ SIA419DJ-T1-GE3	D SIA419DJ-T1-GE3	↔ SIA421DJ-T1-GE3
↳ SIA421DJ-T1-GE3	⊛ SIA425EDJ-T1-GE3	D SIA425EDJ-T1-GE3	⇒ SIA426DJ-T1-GE3	↔ SIA426DJ-T1-GE3
⊛ SIA427DJ-T1-GE3	↳ SIA427DJ-T1-GE3	⊛ SIA429DJ-T1-GE3	↔ SIA429DJ-T1-GE3	↔ SIA430DJ-T1-GE3
D SIA430DJ-T1-GE3	⊛ SIA431DJ	↳ SIA431DJ-T1	⊛ SIA431DJ-T1-GE3	↔ SIA431DJ-T1-GE3
⇒ SIA432DJ-T1-GE3	↔ SIA432DJ-T1-GE3	⊛ SIA433EDJ	↳ SIA433EDJ-T1-GE3	↔ SIA433EDJ-T1-GE3
↔ SIA436DJ-T1-GE3	⇒ SIA443DJ-T1-GE3	D SIA443DJ-T1-GE3	⊛ SIA444DJ-T1-GE3	↳ SIA444DJ-T1-GE3
⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	D SIA445EDJ-T1-GE3	⇒ SIA447DJ-T1-GE3	↔ SIA447DJ-T1-GE3	↔ SIA448DJ-T1-GE3
↳ SIA448DJ-T1-GE3	⊛ SIA449DJ-GE3	↔ SIA450DJ-T1-GE3	⇒ SIA450DJ-T1-GE3	↔ SIA4528-100K
⊛ SIA4528-330K	↳ SIA4528-470K	⊛ SIA453EDJ-T1-GE3	D SIA453EDJ-T1-GE3	↔ SIA456DJ-T1-GE3
↔ SIA456DJ-T1-GE3	⊛ SIA483DJ-T1-GE3	↳ SIA483DJ-T1-GE3	⊛ SIA513DJ-T1-E3	↔ SIA517DJ-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited